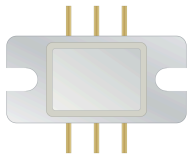
13600–14500 MHz GaN Amplificador de potência encapsulado — PSAT ≥ 41 dBm

LCI-PA-13600-14500-PS41MIN · 13600–14500 MHz · GaN Amplificador de potência encapsulado.



Valores da tabela RF: PSAT ≥ 41 dBm; Ganho de potência ≥ 20 dB; PAE 37 % (típico). Condições de teste RF: Vd = +28 V; Vg = -3.05 V; Pin = 21 dBm; CW.

CMW010B

Aplicar a polarização de porta antes da de dreno. Ao desligar, remover primeiro a de dreno.

Vg: C = 10 µF

Vg: 1, 3

RFin: 2

Vd: 4, 6

RFout: 5

Dimensões do encapsulamento: 18.03 × 8.7 mm.

Características RF

Vd = +28 V; Vg = -3.05 V; Pin = 21 dBm; CW

Parâmetro	Símbolo	Mínimo	Típico	Máximo	Unidade
Frequência de operação	f	13600	-	14500	MHz
Potência de saída saturada	-	41	-	-	dBm
Ganho de potência	-	20	-	-	dB
Eficiência de potência adicionada	-	32	37	-	%
Planicidade do ganho de potência	-	-	0.5	1	dB

Polarização DC e correntes

Parâmetro	Símbolo	Mínimo	Típico	Máximo	Valor	Unidade
Tensão de dreno	-	-	-	-	28	V
Tensão de porta	-	-	-	-	-3.05	V

Valores limite

Valores limite; não são pontos de operação normal.

Parâmetro	Símbolo	Mínimo	Típico	Máximo	Unidade
Tensão dreno-fonte máxima	-	-	-	32	V
Polarização mínima da porta	-	-5	-	-	V
Temperatura de armazenamento	-	-65	-	150	°C
Potência de entrada máxima	-	-	-	24	dBm

Dimensões do encapsulamento

Parâmetro	Valor	Unidade
Dimensões do encapsulamento	18.03 × 8.7	mm
Vão total dos terminais	14.7	mm

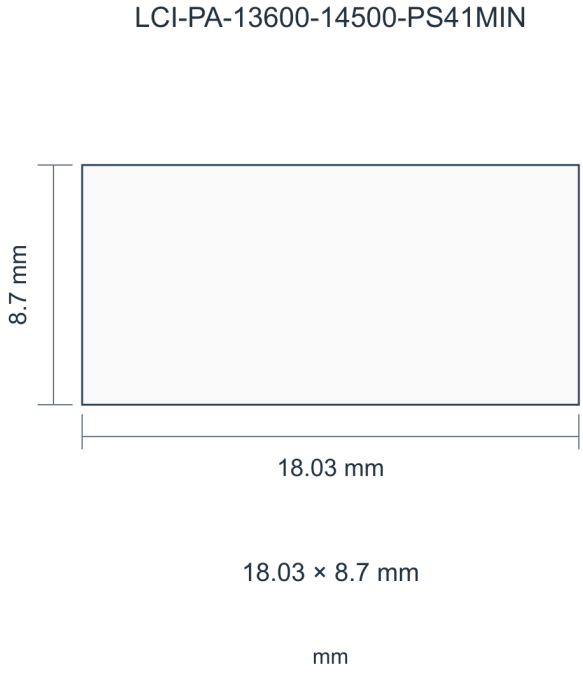
Registro da publicação atual · 1.6 · 2026-11-12. Atualização da descrição ou do conteúdo editorial. Substitui a revisão 1.5.

Notas de integração

CMW010B Aplicar a polarização de porta antes da de dreno. Ao desligar, remover primeiro a de dreno. Vg: C = 10 µF Vg: 1, 3 RFin: 2 Vd: 4, 6 RFout: 5

Desenho dimensional mecânico

Desenho parcial com as dimensões confirmadas em mm. Para a instalação, consulte o desenho completo de instalação.

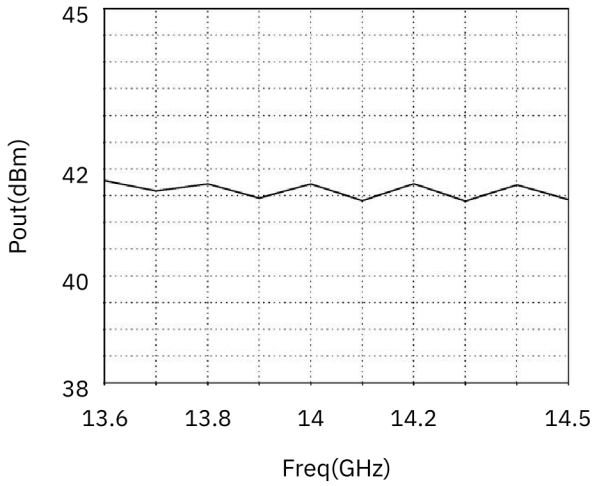


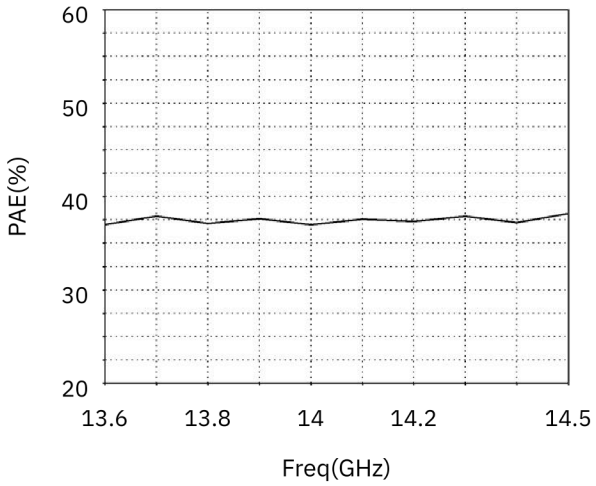
Curvas de desempenho

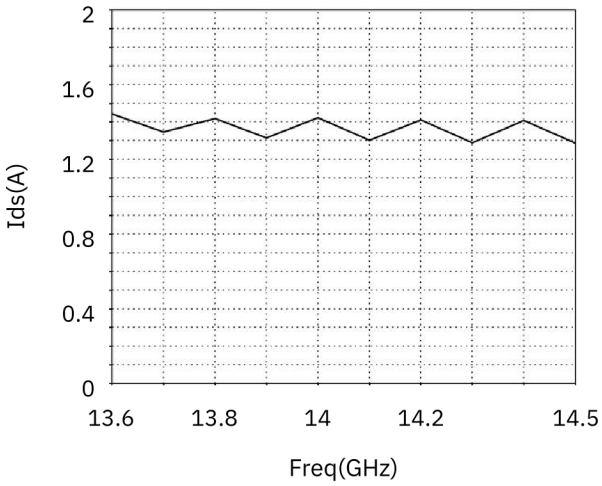
Cada gráfico de desempenho corresponde às condições de operação indicadas na figura.

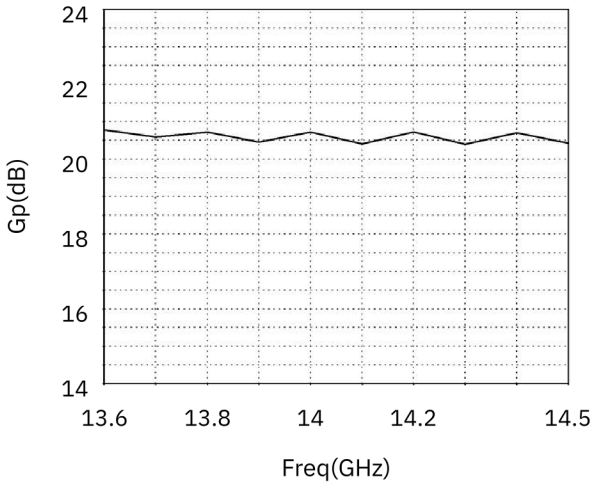
Onda contínua (CW) — Potência de saída saturada; Eficiência de potência adicionada; Corrente dinâmica de dreno; Ganho de potência.

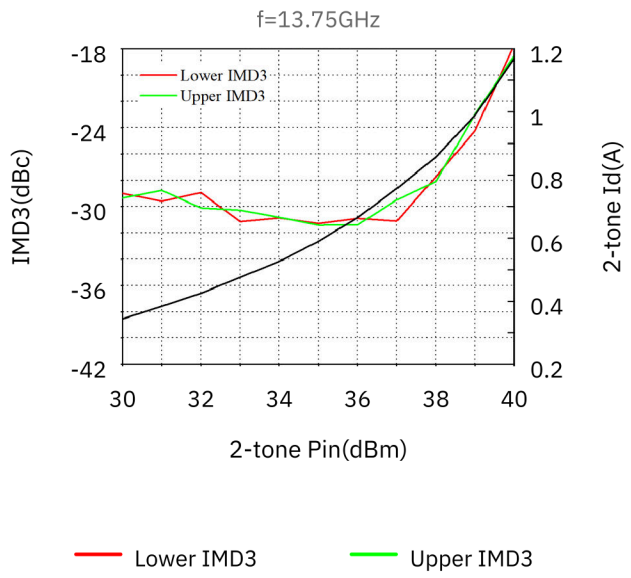
Notas da figura: TA=+25°C; Vd=+28V; Vg=-3.05V; Pin=21dBm.

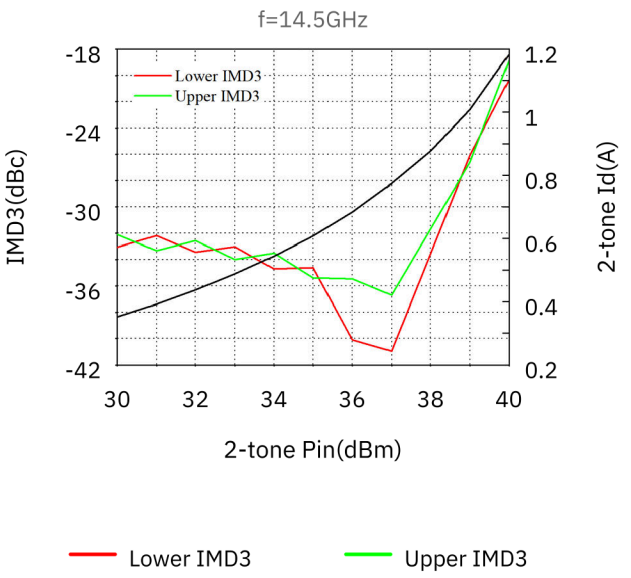


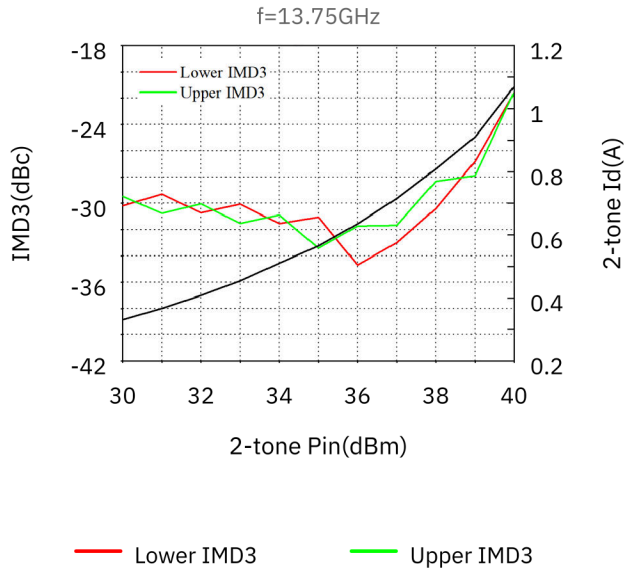


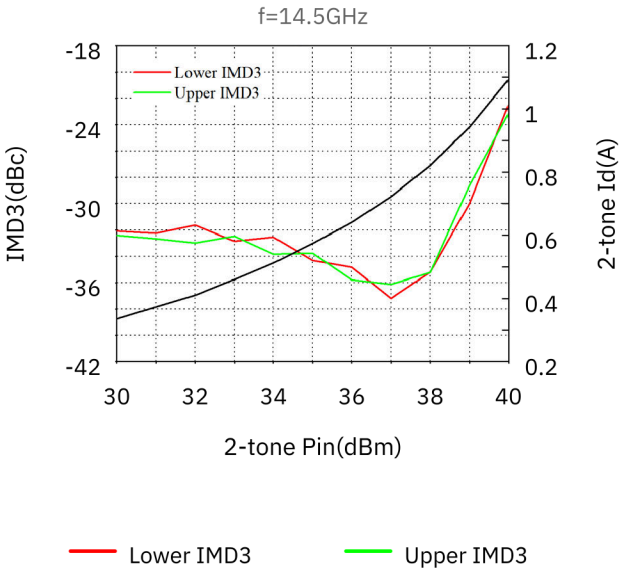












IMD3(dBc); Id(A). f = 13.75/14.5 GHz; Δf = 10 MHz; ID = 200 mA; C = 100 nF (1–2), 200 nF (3–4); Pin de dois tons=30...40 dBm.

Aviso do documento

As especificações podem ser revisadas. Antes de concluir o projeto, confirme com a LCRF a revisão vigente e os requisitos específicos do produto. A proposta aprovada e a documentação do pedido definem a configuração fornecida.